

① 日本国特許庁 (JP) ② 特許出願公開
 ③ 公開特許公報 (A) 昭60-195957

④ Int.Cl.
H 01 L 23/48
23/28

識別記号 廈内整理番号
7357-5F
7738-5F

⑤ 公開 昭和60年(1985)10月4日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑥ 発明の名称 リードフレーム

⑦ 特 願 昭59-50939

⑧ 出 願 昭59(1984)3月19日

⑨ 発明者 谷川喬太

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

⑩ 発明者 中沢洋

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

⑪ 出願人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑫ 代理人 弁理士 高橋明夫

外1名

明細書

発明の名称 リードフレーム

特許請求の範囲

1. 傷面に突出部を設けて成ることを特徴とするリードフレーム。
2. 前記リードフレームがプラスチックモールド用リードフレームである、特許請求の範囲第1項記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モールドレジンとの密着性を良くし、封止性のよい樹脂封止型半導体装置を得ることができるリードフレームに関するもの。

〔背景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1図に示すごときものが周知である(工業調査会刊「IC化実務技術」P137~P150など)。第1図にて、1は半導体チップをマウントするタブ、2はこのタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導

体チップの内部配線をコネクタワイヤにより外部に引出すリードである。このリード側の電極及び半導体チップ側の電極をコネクタワイヤを用いて、周知の超音波ポンディング法などによりポンディングして電気的接続を行った後に、樹脂(レジン)を周知のトランスマーモールド法などにより半導体チップやポンディング部上面にモールドし、リード3を切断成形するなどして樹脂封止型の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂封止型半導体装置にあっては、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、封止性(耐震性)を向上させ、信頼度を向上させることが必要であり、近時は半導体チップの大形化に伴ない、封止巾が増々狭くなってしまい、これら事項の重要性も増大している。

従来のこのよう樹脂封止型の半導体装置に使用されるリードフレームにあっては、その傷面がフラットに構成されており、リードフレームとレジンとの密着性が不足し、封止性、信頼度の向上という面で問題があることがわかった。

〔発明の目的〕

本発明はリードフレームとレジンとの密着（接觸）面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、封止性を向上し、信頼度の高い樹脂封止型半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面からあきらかになるであろう。

〔発明の概要〕

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に設付けを行い、レジンとの接觸面を増大させ、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リードフレーム表面積増大によるリークバスの伸長をはかって外部からの侵入等の侵透性異物の侵入の半導体チップへの到達時間を長くして、封止性

を向上させ、製品寿命を延命し、信頼性を向上させることに成功した。

〔実施例〕

次に、本発明を実施例に基づき説明する。

第2図は本発明リードフレームの要部斜視図、第3図は第2図I-I線断面図を示す。

これら図において、4は半導体チップを搭載するためのチップ、5はタブ吊りリード、6はリード、7は樹脂モールド上に必要な樹脂穴である。本発明リードフレームにあっては、これら図に例示するように、タブ4とタブ吊りリード5及びリード6側面に突出部8を設けて成る。この突出部8の形成は、例えば、通常の方法により側面がフラットに形成されたリードフレームの周縁部から適宜端を上下からプレス機械により押圧して当該側面から突出部が突出するよう形成してもよいし、又エッティングにより周縁部から適宜端を上下から適宜の深さでエッティング除去することにより形成してもよく、その他適宜の方法が採用できる。

第4図は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂封止型半導体装置の断面図を示し、第4図にて、9は半導体チップ、10はコネクタワイヤ、11は樹脂封止体、12はリードフレームで半導体チップ9を搭載しているタブ13、及び半導体チップ9の内部配線をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えばシリコン半導晶基板より成り、周知の技術によって、このチップ内には多数の回路素子が形成され、1つの回路機能を与えている。回路素子は例えば絶縁ゲート型電界効果トランジスタ（MOSトランジスタ）から成り、これらの回路素子によって、例えば論理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミニウム（Al）細線により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエポキシ樹脂により構成され、周知のトランസファーモールド法などにより形成される。次に、第5図は本発明の他の

実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の間隔で横方向に複数の線状の導部16を設けて成る実施例を示す。近時、第4図に示すような樹脂封止型半導体装置において、半導体チップ9が大形化し、リード14の樹脂封止体11に埋込まれる長さが次第に短くなっている。そうすると、リード14を折曲げて第4図に示すような折曲げリードとする場合、折曲げ時にリードがゆるみ、リードがレジンからスリップし、リードが樹脂封止体外部によけいに引っぱり出されることになる。かかる導部16を設けることにより、より一層、リードフレームとレジンとの密着性を向上し得る。

〔効 果〕

(1) リードフレームの切削面に設付けを行ない、側面に突出部を形成するようにしたので、その分リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、リードフレームとレジンとの密着性の向上が図られる。

(2) 密着面積の増大により、レジン量が増大し、

かつ、側面がフラットである場合に比較して、側面が形成されているのでリードバスが長くなり、その結果外部からの半導体装置内部への侵入性異物の侵入が遅くなり耐止性(耐湿性)が向上する。

- (3) リードフレームとレジンとの密着性、耐止性の向上により製品寿命を延命し、樹脂封止型半導体装置の信頼性を著しく向上することができる。
- (4) 半導体チップが大型化し、リードのモールドレジン中へ組み込まれている部分が増々粗くなっている今日、リードフレームに段付けを行い、リードフレームとレジンとの密着性の向上の限り、耐止性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し得ることは工業上極めて有意味である。
- (5) リードフレームの側面に突出部を設けることにより、リードの上面に溝部を形成することにより、より一層リードフレームとレジンとの密着性が向上させることができ、さらにリード折曲げ成形に際し、リードがゆるんだり、樹脂封止体の外部に突出したりすることを防止できる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例にとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨は説明しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、前記実施例では、リードフレーム側面全体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出部を設けても差支えない。又前記実施例では側面をリード上面のみに設けた例を示したが、リードの上下面あるいは下面のみに設けてよい。

【利用分野】

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのパッケージの他、フラットパックタイプのパッケージなど他の樹脂封止型半導体装置にも適用することができ、樹脂封止型半導体装置全般に適用できる。又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。

図面の簡単な説明

第1図はリードフレームの従来例を示す平面図。

第2図は本発明リードフレームの要部斜視図。

第3図は第2図I-I線断面図。

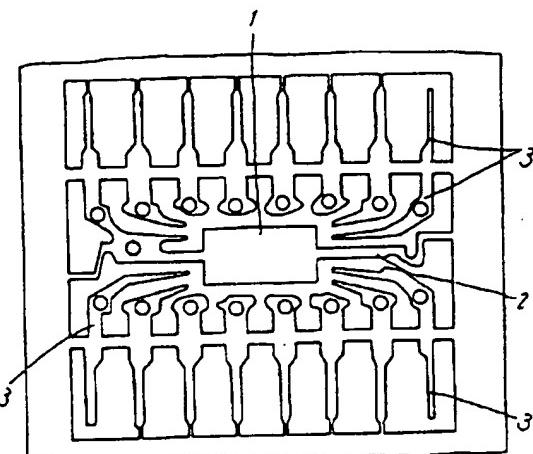
第4図は本発明リードフレームを使用して成る樹脂封止型半導体装置の断面図。

第5図は本発明の他の実施例を示すリードフレームの平面図である。

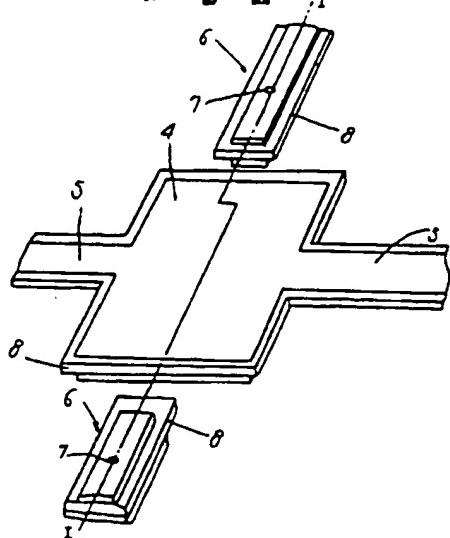
1…タブ、2…タブ吊りリード、3…リード、
4…タブ、5…タブ吊りリード、6…リード、7…
…樹脂穴、8…突出部、9…半導体チップ、10…
…コネクタワイヤ、11…樹脂封止体、12…リード
フレーム、13…タブ、14…リード、15…
…突出部、16…背部。

代理人弁理士高橋明夫

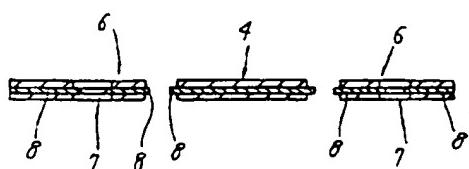
第1図



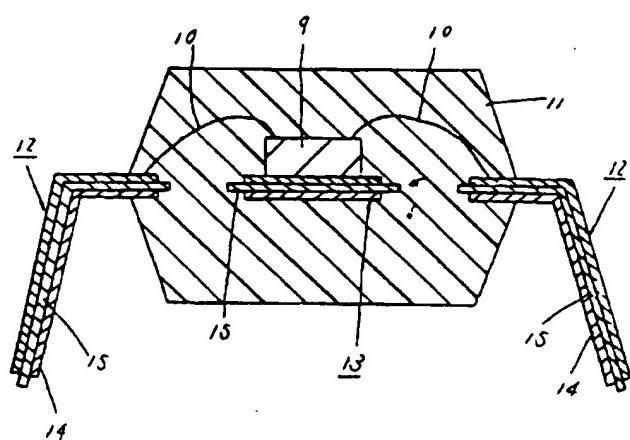
第 2 図



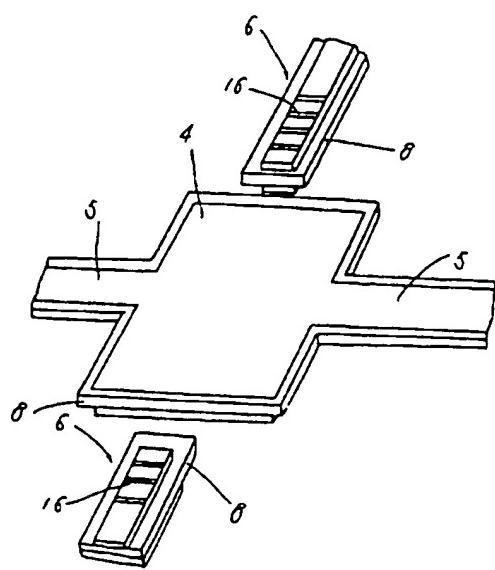
第 3 図



第 4 図



第 5 図



Abstract of Japanese Patent Office Gazette
No. H6-140563

SEMICONDUCTOR DEVICE

Inventor: Tsuji Masahiro
Applicant: Rohm Co., Ltd.
Filed: Oct. 23, 1992
Disclosed: May 20, 1994

PURPOSE: To provide a semiconductor device prevented from generating the exfoliations of a resin from a die pad in a chain-reacting way and from generating the cracks of the resin, by improving the adhesiveness of the resin to the die pad in the corner of the die pad wherein the exfoliations are especially apt to occur, in the resin-sealed semiconductor device including a semiconductor chip die-bonded to the die pad.

CONSTITUTION: On each sidewall of a die pad 1, a recessed part 11 or a protruding part or the combination thereof is formed. Then, a resin 6 is made to eat into the recessed part 11 or to cover completely the protruding part, and concurrently, the effect of the difference between the thermal expansion coefficients of the resin 6 and the die pad 1 is made small by covering thin protruding parts 12 of the die pad 1 with the resin 6. Thereby, the adhesiveness of the resin 6 to the die pad 1 is improved.

② 日本国特許庁 (JP) ③ 特許出願公開
 ④ 公開特許公報 (A) 昭60-195957

⑤ Int.Cl.
H 01 L 23/48
23/28

識別記号

府内整理番号

⑥ 公開 昭和60年(1985)10月4日

7357-5F
7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑦発明の名称 リードフレーム

⑧特 願 昭59-50939

⑨出 願 昭59(1984)3月19日

⑩発明者 谷川 喬太 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内
 ⑪発明者 中沢 洋 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内
 ⑫出願人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
 ⑬代理人 弁理士 高橋 明夫 外1名

明細書

発明の名称 リードフレーム

特許請求の範囲

1. 側面に突出部を設けて成ることを特徴とするリードフレーム。
2. 前記リードフレームがプラスチックモールド用リードフレームである、特許請求の範囲第1項記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モールドレジンとの密着性を良くし、封止性のよい樹脂封止型半導体装置を得ることができるリードフレームに関するもの。

〔背景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1図に示すごときものが周知である（工業調査会刊「IC化実務技術」P137～P150など）。第1図にて、1は半導体チップをマウントするタブ、2はこのタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導

体チップの内部配線をコネクタワイヤにより外部に引出するリードである。このリード側の電極及び半導体チップ側の電極をコネクタワイヤを用いて、周知の超音波ポンディング法などによりポンディングして電気的接続を行った後に、樹脂（レジン）を周知のトランスマーモールド法などにより半導体チップやポンディング部上にモールドし、リード3を切断成形するなどして樹脂封止型の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂封止型半導体装置にあっては、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、封止性（耐湿性）を向上させ、信頼度を向上させることが必要であり、近時は半導体チップの大形化に伴ない、封止巾が増々狭くなつており、これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂封止型の半導体装置に使用されるリードフレームにあっては、その側面がフラットに構成されており、リードフレームとレジンとの密着性が不足し、封止性、信頼度の向上という面で問題があることがわかった。

【発明の目的】

本発明はリードフレームとレジンとの密着(接觸)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、封止性を向上し、信頼度の高い樹脂封止型半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は、本明細書の記述および図面からあきらかになるであろう。

【発明の概要】

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に設付けを行い、レジンとの接觸面を増大させ、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リードフレーム表面積増大によるリードバスの伸長をはかって外部からの湿気等の浸透性異物の侵入の半導体チップへの到達時間を長くして、封止性

を向上させ、製品寿命を延命し、信頼性を向上させることに成功した。

【実施例】

次に、本発明を実施例に基づき説明する。

第2図は本発明リードフレームの要部斜視図、第3図は第2図I-I線断面図を示す。

これら図において、4は半導体チップを搭載するためのタブ、5はタブ吊りリード、6はリード、7は樹脂モールドに必要な樹脂穴である。本発明リードフレームにあっては、これら図に示すように、タブ4やタブ吊りリード5及びリード6側面に突出部8を設けて成る。この突出部8の形成は、例えば、通常の方法により側面がフラットに形成されたリードフレームの周端部から適宜幅を上下からプレス機械により押圧して当該側面から突出部が突出するよう形成してもよいし、又エッティングにより周端部から適宜幅を上下から適宜の深さでエッティング除去することにより形成してもよく、その他適宜の方法が採用できる。

第4図は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂封止型半導体装置の断面図を示し、第4図にて、9は半導体チップ、10はコネクタワイヤ、11は樹脂封止体、12はリードフレームで半導体チップ9を搭載しているタブ13、及び半導体チップ9の内部配線をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えばシリコン単結晶基板より成り、周知の技術によって、このチップ内には多数の回路素子が形成され、1つの回路機能を与えている。回路素子は例えば絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトランジスタ)から成り、これらの回路素子によって、例えば論理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミニウム(Al)細線により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエポキシ樹脂により構成され、周知のトランスマルチモールド法などにより形成される。次に、第5図は本発明の他の

実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の間隔で横方向に複数の溝状の溝部16を設けて成る実施例を示す。近時、第4図に示すような樹脂封止型半導体装置において、半導体チップ9が大形化し、リード14の樹脂封止体11に埋込まれる長さが次第に短くなっている。そうすると、リード14を折曲げて第4図に示すような折曲げリードとする場合、折曲げ時にリードがゆるみ、リードがレジンからスリップし、リードが樹脂封止体外部によけいに引っぱり出されることになる。かかる溝部16を設けることにより、より一層、リードフレームとレジンとの密着性を向上し得る。

【効果】

(1) リードフレームの切断面に設付けを行ない、側面に突出部を形成するようにしたので、その分リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、リードフレームとレジンの密着性の向上が図られる。

(2) 密着面積の増大により、レジン量が増大し、

かつ、側面がフラットである場合に比較して、側面が形成されているのでリードバスが長くなり、その結果外部からの半導体装置内部への侵透性異物の侵入が遅くなり封止性(耐湿性)が向上する。

(3) リードフレームとレジンとの密着性、封止性の向上により製品寿命を延命し、樹脂封止型半導体装置の信頼性を著しく向上することができる。

(4) 半導体チップが大型化し、リードのモールドレジン中へ埋め込まれている部分が増々短くなっている今日、リードフレームに設付けを行い、リードフレームとレジンとの密着性の向上の限り、封止性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し得ることは工業上極めて有意味である。

(5) リードフレームの側面に突出部を設けることにより、第5図に示すように、リードの上面に溝部を形成することにより、より一層リードフレームとレジンとの密着性が向上させることができ、さらにリード折曲げ成形に際し、リードがゆるんなり、樹脂封止体の外端に突出したりすることを防止できる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例にまとめて具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨は途絶しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、前記実施例では、リードフレーム側面全体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出部を設けても差支えない。又前記実施例では側面をリード上面のみに設けた例を示したが、リードの上下面あるいは下面のみに設けてもよい。

【利用分野】

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのパッケージの他、フラットパッケータイプのパッケージなど他の樹脂封止型半導体装置にも適用することができ、樹脂封止型半導体装置全般に適用できる。又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。

図面の簡単な説明

第1図はリードフレームの従来例を示す平面図。

第2図は本発明リードフレームの要部斜視図。

第3図は第2図I-I線断面図。

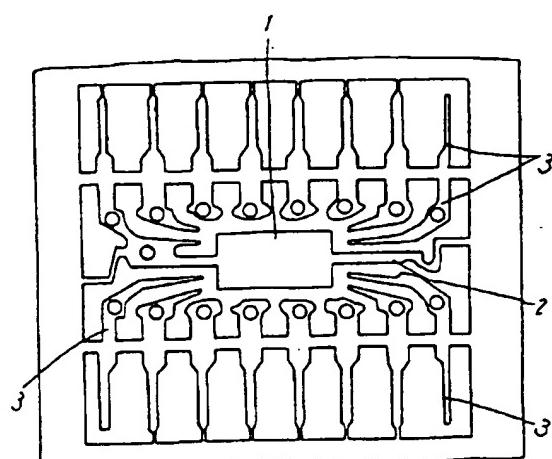
第4図は本発明リードフレームを使用して成る樹脂封止型半導体装置の断面図。

第5図は本発明の他の実施例を示すリードフレームの平面図である。

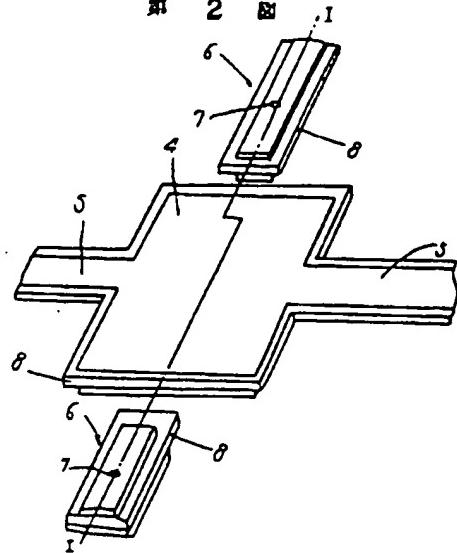
1…タブ、2…タブ吊りリード、3…リード、
4…タブ、5…タブ吊りリード、6…リード、7…樹脂穴、8…突出部、9…半導体チップ、10…コネクタワイヤ、11…樹脂封止体、12…リードフレーム、13…タブ、14…リード、15…突出部、16…溝部。

代理人弁理士 高橋 明夫

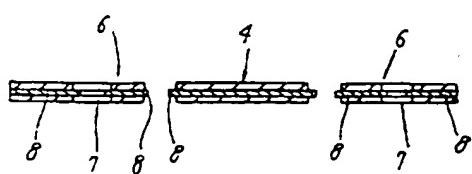
第1図



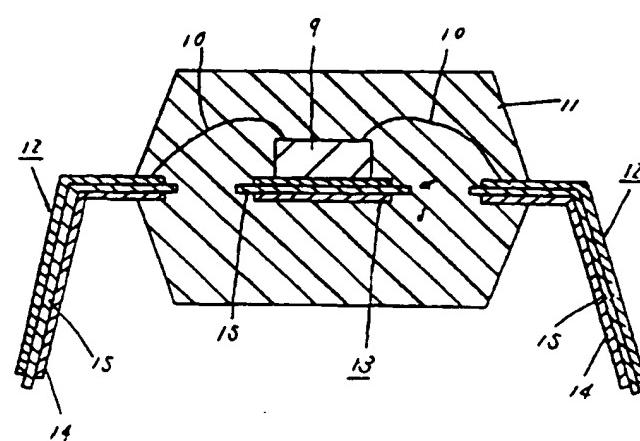
第 2 図



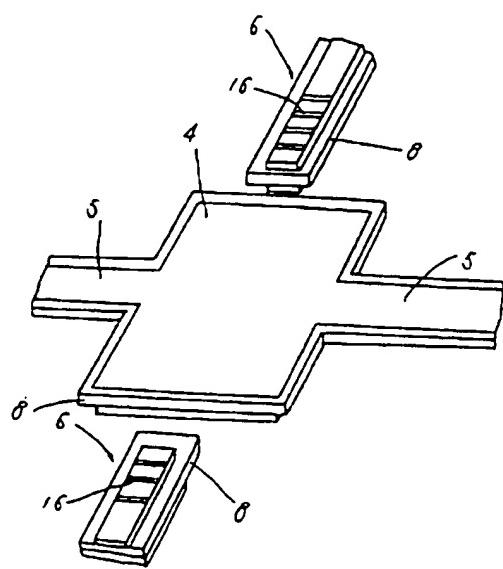
第 3 図



第 4 図



第 5 図



Abstract of Japanese Patent Office Gazette
No. H6-140563

SEMICONDUCTOR DEVICE

Inventor: Tsuji Masahiro
Applicant: Rohm Co., Ltd.
Filed: Oct. 23, 1992
Disclosed: May 20, 1994

PURPOSE: To provide a semiconductor device prevented from generating the exfoliations of a resin from a die pad in a chain-reacting way and from generating the cracks of the resin, by improving the adhesiveness of the resin to the die pad in the corner of the die pad wherein the exfoliations are especially apt to occur, in the resin-sealed semiconductor device including a semiconductor chip die-bonded to the die pad.

CONSTITUTION: On each sidewall of a die pad 1, a recessed part 11 or a protruding part or the combination thereof is formed. Then, a resin 6 is made to eat into the recessed part 11 or to cover completely the protruding part, and concurrently, the effect of the difference between the thermal expansion coefficients of the resin 6 and the die pad 1 is made small by covering thin protruding parts 12 of the die pad 1 with the resin 6. Thereby, the adhesiveness of the resin 6 to the die pad 1 is improved.

English Transl. by

57

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 60-195957
(43) Date of publication of application : 04.10.1985

(51) Int.CI.

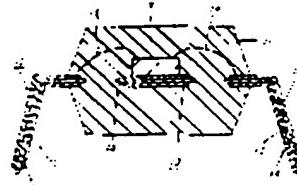
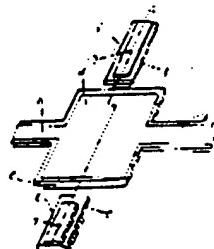
H01L 23/48
H01L 23/28(21) Application number : 59-050939
(22) Date of filing : 19.03.1984(71) Applicant : HITACHI LTD
(72) Inventor : TANIGAWA TAKAHIRO
NAKAZAWA HIROSHI

(54) LEAD FRAME

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface with the resin.

CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the known technique, and one circuit function is formed. A resin sealer 11 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.



LEGAL STATUS

- [Date of request for examination]
- [Date of sending the examiner's decision of rejection]
- [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
- [Date of final disposal for application]
- [Patent number]
- [Date of registration]
- [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of extinction of right]

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 60195957
PUBLICATION DATE : 04-10-85

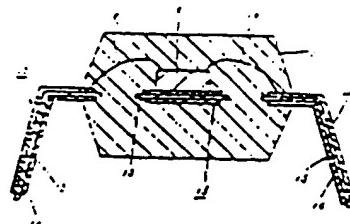
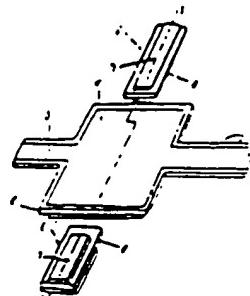
APPLICATION DATE : 19-03-84
APPLICATION NUMBER : 59050939

APPLICANT : HITACHI LTD;

INVENTOR : NAKAZAWA HIROSHI;

INT.CL. : H01L 23'48 H01L 23/28

TITLE : LEAD FRAME



ABSTRACT : PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface with the resin.

CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer 11 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.

COPYRIGHT: (C)1985.JPO&Japio

④公開特許公報(A) 昭60-195957

④Int.Cl.
H 01 L 23/48
23/28

識別記号

厅内整理番号

7357-5F
7738-5F

④公開 昭和60年(1985)10月4日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

④発明の名称 リードフレーム

④特 賦 昭59-50939
④出 願 昭59(1984)3月19日④発明者 谷川 邦太 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武藏工場内
④発明者 中沢 洋 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武藏工場内
④出願人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
④代理人 弁理士 高橋 明夫 外1名

明細書

発明の名称 リードフレーム

特許請求の範囲

1. 背面に突出部を設けて成ることを特徴とするリードフレーム。
2. 前記リードフレームがプラスチックモールド用リードフレームである、特許請求の範囲1項記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モールドレジンとの密着性を良くし、封止性のよい樹脂封止部半導体装置を得ることができるリードフレームに関するもの。

〔背景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1図に示すとおりものが周知である(工業調査会刊「IC化実務技術」P137-P150など)。第1図にて、1は半導体チャップをマウントするタブ、2はこのタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導

体チャップの内部配線をコネクタワイヤにより外部に引出するリードである。このリード側の電極及び半導体チャップ側の電極をコネクタワイヤを用いて、尾知の圧着放電ポンディング法などによりポンディングして電気的接続を行った後、樹脂(レジン)を尾知のトランスマッソーホルダ法などにより半導体チャップやポンディング部上にモールドし、リード3を切断成形するなどして樹脂封止部の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂封止部半導体装置にあっては、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、封止性(耐候性)を向上させ、信頼度を向上させることが必要であり、近時は半導体チャップの大形化に伴ない、封止巾が増々狭くなってしまい、これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂封止部の半導体装置に使用されるリードフレームにあっては、その側面がフラットに構成されており、リードフレームとレジンとの密着性が不足し、封止性、信頼度の向上という面で問題があることがわかった。

〔発明の目的〕

本発明はリードフレームとレジンとの密着(接着)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、封止性を向上し、信頼度の高い遮断防止部半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびにその他の目的と手段たるまゝは、本明細書の記述および図面からあきらかになるであろう。

〔発明の概要〕

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に取付けを行い、レジンとの接着力を増大させ、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リードフレーム表面積増大によるリードバスの伸長をなかつて外部からの直撃等の侵透性異物の侵入の半導体チップへの到達時間を長くして、封止性

を向上させ、製品寿命を延命し、信頼性を向上させることを達成した。

〔実施例〕

次に、本発明を実施例に基づき説明する。

第1図は本発明リードフレームの断面構造、第2図は第1図I-I部断面図を示す。

これら図において、4は半導体チップを保持するためのタブ、5はタブ吊りリード、6はリード、7は遮断モールドに必要な遮断穴である。本発明リードフレームにあっては、これら図に表示するよう、タブ4、タブ吊りリード5、及びリード6側面に突出部8を設けて成る。この突出部8の形成は、例えば、通常の方法により側面がフラットに形成されたリードフレームの裏端面から遮断部を上下からプレス抜模により押圧して当該側面から突出部が突出するよう形成してもよいし、又ニッティングにより遮断部から遮断部を上下から遮断部までニッティング除去することにより形成してもよく、その他の通常の方法が使用できる。

第3図は本発明リードフレームを使用して成る

遮断防止部半導体装置の断面図を示し、第4図にて、9は半導体チップ、10はコネクタワイヤ、11は遮断防止体、12はリードフレームで半導体チップ9を搭載しているタブ13、及び半導体チップ9の内部配線をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えばシリコン半導体基板より成り、専門の技術によって、このチップ内には多数の回路素子が形成され、1つの回路素子を拿えている。回路素子は例えば絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトランジスター)から成り、これらの回路素子によって、例文に論理回路およびメモリの回路構成が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミニウム(Al)被覆により構成される。

遮断防止体11は、例えばエポキシ樹脂により構成され、専門のトランシスファー・モールド法などにより形成される。次に、第5図は本発明の他の

実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、遮断の周囲で横方向に複数の側面の側面16を設けて成る実施例を示す。近時、第4図に示すような遮断防止部半導体装置において、半導体チップ9が大形化し、リード14の側面防止体11に埋込まれる長さが次第に短くなっている。そうすると、リード14を折曲げて第4図に示すような折曲げリードとする場合、折曲げたリードがゆるみ、リードがレジンからスリップし、リードが遮断防止体外側によけいに引っぱり出されることになる。かかる戻部16を設けることにより、より一層、リードフレームとレジンとの密着性を向上し得る。

〔効果〕

(1) リードフレームの切削面に取付けを行ない、側面に突出部を形成するようにしてしたので、その分リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、リードフレームとレジンの密着性の向上が図られる。

(2) 密着面積の増大により、レジン量が増大し、

かつ、側面がフラットである場合に比較して、頂が形成されているのでリードバスが長くなり、その結果外記からの半導体基板内記への接続性の侵入が遅くなり制止性（耐震性）が向上する。

(3) リードフレームとレジンとの密着性、制止性の向上により設品寿命を延長し、街路制止用半導体装置の信頼性を著しく向上することができる。

(4) 半導体チップが大面化し、リードのモールドレジン中へ埋め込まれている部分が増々多くなっている今日、リードフレームに取付けを行い、リードフレームとレジンとの密着性の向上の限り、制止性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し得ることは工業上極めて有意味である。

(5) リードフレームの側面に突出部を設けることにより、第5図に示すように、リードの上面に溝記を形成することにより、より一層リードフレームとレジンとの密着性が向上させることができ、さらにリード折曲げ成形に因し、リードがゆるんだり、街路制止体の外記に突出したりすることを防止できる。

第4図は本発明リードフレームを使用して成る街路制止用半導体装置の断面図。

第5図は不発明の他の実施例を示すリードフレームの断面図である。

1…チップ、2…チップ吊りリード、3…リード、4…チップ、5…チップ吊りリード、6…リード、7…溝記穴、8…突出部、9…半導体チップ、10…コネクタワイヤ、11…街路制止体、12…リードフレーム、13…チップ、14…リード、15…突出部、16…溝記。

代理人弁理士高橋昭夫

以上本発明によってなされた改良を実現的ともづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨に沿わない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、前記実施例では、リードフレーム側面全体に突出部を設けた例を示したが、一筋に突出部を設けても差支えない。又前記実施例では側面をリード上面のみに設けた例を示したが、リードの上下面あるいは下底のみに設けててもよい。

〔利用分野〕

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのパッケージの他、フラットパッケータイプのパッケージなど他の複数制止用半導体装置にも適用することができ、街路制止用半導体装置全般に適用できる。又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。

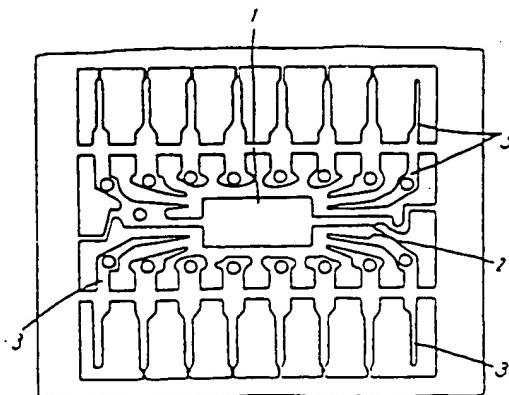
図版の簡単な説明

第1図はリードフレームの從来例を示す平面図。

第2図は本発明リードフレームの要部断面図。

第3図は第2図I-I断面図。

第1図



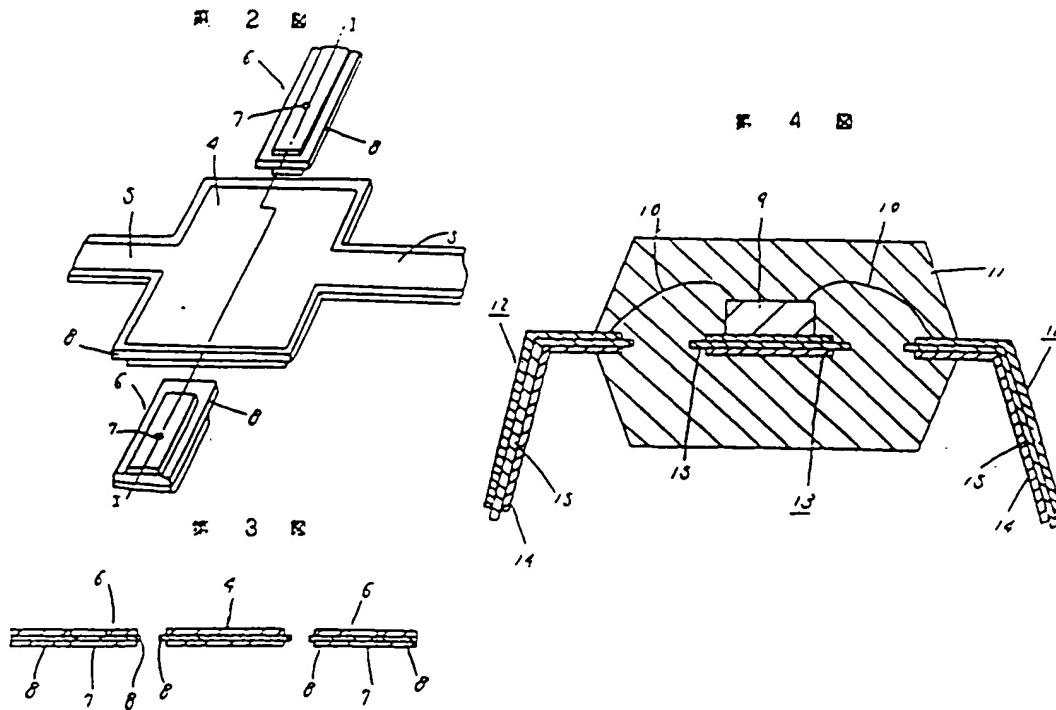
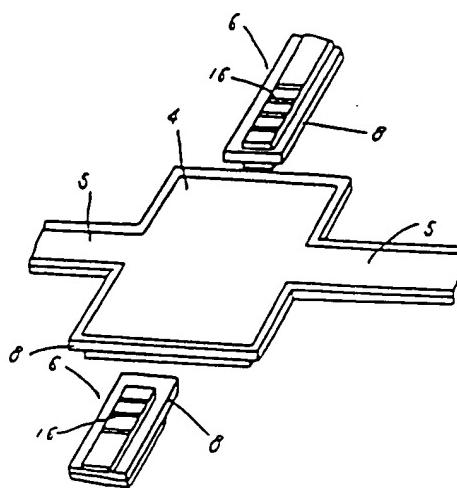


図 5



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.